


	<h2 style="color: red;">FQD3N60TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD3N60TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD3N60TF.pdf 2.FQD3N60TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 31988 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD3N60TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	31988 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 2.4A (Tc) 2.5W (Ta), 50W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.6 Ohm @ 1.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	450pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD3N60TF ist neu im Original, Suche FQD3N60TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD3N60TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD3N60TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD3N60CS FSC FQD3N60CS FSC</p>	 <p>FQD3N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK</p>	 <p>FQD3N60CTM FSC FQD3N60CTM FSC</p>	 <p>FQD3P20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.4A DPAK</p>
 <p>FQD3N60TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK</p>	 <p>FQD3N60CTM_WS Fairchild/ON Semiconductor FQD3N60CTM_WS Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FQD3N60TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK</p>	 <p>FQD3N60CTF VB FQD3N60CTF VB</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⊕ FQD30N06TF ⊕ FQD30N06TM ⊕ FQD3N30TM D FQD3N50C/CS ⇒ FQD3N60C ⇒ FQD3N60TF ⊕ FQD3P50TF ⊕ FQD4N20LTF ⊕ FQD4N20TM ⇒ FQD4N50TF 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ FQD30N06TF ⊕ FQD30P06 ⊕ FQD3N30TM ⊕ FQD3N50CTF ⇒ FQD3N60CS ⇒ FQD3N60TM D FQD3P50TF ⊕ FQD4N20LTF ⊕ FQD4N25TM ⊕ FQD4N50TF 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ FQD30N06TF_F080 D FQD3N25T ⊕ FQD3N40TM ⊕ FQD3N50CTF ⊕ FQD3N60CTF D FQD3N60TM ⇒ FQD3P50TM ⇒ FQD4N20TF ⊕ FQD4N25TM ⊕ FQD4N50TM 	<ul style="list-style-type: none"> D FQD30N06TF_F080 ⇒ FQD3N30TF ⇒ FQD3N40TM ⊕ FQD3N50CTM ⊕ FQD3N60CTM ⊕ FQD3P20TF ⇒ FQD3P50TM ⇒ FQD4N20TF D FQD4N50S ⊕ FQD4N50TM 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ FQD30N06TM ⇒ FQD3N30TF ⇒ FQD3N50C ⇒ FQD3N50CTM ⇒ FQD3N60CTM_WS ⊕ FQD3P20TF ⇒ FQD4N20L ⇒ FQD4N20TM ⇒ FQD4N50T ⇒ FQD4N60C
--	--	---	---	--

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited